



成都仕芯半导体有限公司

2026产品目录



以严谨高效的态度、创新的技术，为您提供完善周到的射频微波、毫米波及数模混合集成电路及模块产品和服务。



版本：2026年02月 (V33)

成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd.)成立于2017年8月,是一家专业从事射频/微波集成电路芯片,组件和系统解决方案的设计、开发、生产销售的高科技公司。公司位于成都高新西区百川路9号,具备技术能力过硬的专业团队,联合了电子科技大学、西北工业大学等多家知名大学的专家教授、博士生导师、高级工程师和科研骨干,为产品的设计、研发提供了有力的技术保障。

微波高频集成电路芯片是半导体产业的一个重要分支,是通信,仪器仪表等多领域的核心支撑产品。我们依托于公司创业团队雄厚的技术储备,致力于满足国内外市场日益增长的对高性能,高集成度和低成本的高频率集成芯片的需求,为国内外客户提供自主研发的射频/微波集成电路芯片和组件产品。我们将不断优化设计技术和生产工艺,丰富产品种类,积累客户资源,立足国内、面向海外,力争在最短时间内发展成为射频/微波器件及系统领域的国际一流企业。

公司的质量方针是“用户至上、技术创新、严谨高效、持续改进”。

目录

1	明星产品推荐	1
1.1	无源混频器芯片 (替代 LTCXXX 系列产品)	1
1.2	频综芯片	1
1.3	鉴相器	2
1.4	锁相环芯片	2
1.5	宽带 VCO	3
1.6	对数检波器芯片	3
1.7	分频器芯片	4
1.8	放大器芯片	5
1.9	开关芯片	6
1.10	固定衰减器	7
1.11	数控衰减器芯片	7
1.12	耦合器芯片	7
2	检波器芯片	8
2.1	对数检波器芯片	8
3	锁相环芯片	9
3.1	频综芯片	9
3.2	鉴相器芯片	9
3.3	小数分频锁相环芯片	10
4	电调延时器芯片	10
4.1	模拟电调延时器芯片	10
5	VCO 芯片	11
5.1	窄带 VCO 芯片	11
5.2	宽带 VCO 芯片	13
6	分频器芯片	14
6.1	可编程分频器芯片	14
6.2	固定分频器芯片	15
7	梳状谱发生器芯片	15
7.1	奇数次梳状谱发生器芯片	15
7.2	连续梳状谱发生器芯片	15
8	混频器芯片	16
8.1	无源 IQ 混频器芯片	16
8.2	无源混频器芯片	16
8.3	带本振驱动混频器芯片	17
8.4	有源混频器芯片	17
9	下变频器芯片	18
9.1	IQ 下变频器芯片	18
10	功分器芯片	18
10.1	一分二功分器芯片	18
10.2	耦合器芯片	18
11	衰减器芯片	19
11.1	数控衰减器芯片	19

11.2	固定衰减器芯片	20
11.3	温补衰减器芯片	20
12	放大器芯片	21
12.1	低噪声放大器芯片	21
12.2	Gain Block 放大器芯片	23
12.3	中功率放大器芯片	23
12.4	低相位噪声放大器芯片	24
12.5	运算放大器芯片	24
13	倍频器芯片	25
13.1	二倍频器芯片	25
14	数模转换器芯片	25
14.1	10 位数模转换器芯片	25
15	均衡器芯片	25
15.1	电调均衡器芯片	25
16	电源芯片	25
16.1	LDO 电源芯片	25
17	开关芯片	26
18	移相器芯片	28
18.1	模拟移相器芯片	28
18.2	数字移相器芯片	28
18.3	模拟延迟线芯片	28
19	滤波器芯片	29
19.1	固定低通滤波器芯片	29
19.2	固定高通滤波器芯片	30
19.3	固定带通滤波器芯片	30
19.4	电调低通滤波器芯片	30
19.5	电调带通滤波器芯片	30
附录	封装外形简介	31
1	塑料封装	31
2	陶瓷封装	31

1 明星产品推荐

1.1 无源混频器芯片（替代 LTCXXX 系列产品）

指标 型号	RF 频率范围 (GHz)	本振频率范 围 (GHz)	中频频率范围 (GHz)	本振驱动功 率 (dBm)	RF 回波损 耗 (dB)	输入 P1dB (dBm)	变频损耗/ (dB)	LO-RF 隔离 度 (dB)	输入 IP3 (dBm)	芯片/封装尺寸
SIM442ZSP5D	1.3~2.7	1.7~2.5	0.005~0.5	-6~6	10	11	6	33	25.5	5*5 QFN-20L
SIM444ZSP23	2~20	1~20	DC~6	-3~6	15	17	8.5	40	21.4	2*3 QFN-12L
SIM445ZSP23	2~20	1~20	0.5~9	-3~6	15	17	9.8	40	23	2*3 QFN-12L
SIM287ZSP23	2~14	1~12	0.5~6	-6~6	15	18	8.8	55	25.5	2*3 QFN-12L
SIM295ZSP23	2~14	1~12	DC~6	-6~6	15	18	7.4	45	22.8	2*3 QFN-12L

1.2 频综芯片

指标 型号	频率范围 (GHz)	归一化噪底 (dBc/Hz)	最高鉴相频率 (MHz)	VCO 基频 (GHz)	相位噪声@10kHz (dBc/Hz)	工作电压 (V)	芯片/封装尺寸
<u>SIPL447Z (New)</u>	0.005~0.4	-230	200	/	-131@100MHz	3.3	Die
<u>SIPL450ZSP5 (New)</u>	0.03~7.5	-228@整数模式 -225@小数模式	10~100@整数模式 10~100@小数模式	3.75~7.5	-104@3.8GHz	3.3	5*5 QFN-32L
SIPL452SP6	0.078125~20	-232@整数模式 -227@小数模式	10~200@整数模式 10~100@小数模式	10~20	-100@20GHz	3.3	6*6 QFN-40L
SIPL457SP6	0.078125~20	-232@整数模式 -229@小数模式	10~200@整数模式 10~100@小数模式	10~20	-100@20GHz	3.3	6*6 QFN-40L
SIPL351SP6	0.078125~20	-235@整数模式 -230@小数模式	2~200@整数模式 2~50@小数模式	10~20	-101@20GHz	3.3	6*6 QFN-40L
SIPL364SP6	0.9375~15	-235@整数模式 -230@小数模式	2~200@整数模式 2~50@小数模式	7.5~15	-101@15GHz	3.3	6*6 QFN-40L
SITR229ASP4C	23~25	-230@整数模式	5~200@整数模式 5~150@小数模式	23~25	-92@24.8GHz	3.3	4*4 QFN-32L

注：SIPL452SP6 与 SIPL457SP6 的区别为：SIPL452SP6 为单片频率源芯片，N 分频器前带前置二分频；SIPL457SP6 无前置二分频器。

成都仕芯半导体有限公司

1.3 鉴相器

型号	指标	鉴相频率 (GHz)	射频输入频率 (GHz)	射频分频数	相位噪声 (dBc/Hz) @100KHz	归一化底噪 (dBc/Hz)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	芯片/封装尺寸
SIPL187ZSP5		0.1~1	0.2~20	12~2048	-108 (Fpd=100MHz, Fout=20GHz)	-236	3.3	250	5*5 QFN-32L
SIPL369Z		0.01~1	0.01~1	1	-106 (Fpd=100MHz, Fout=20GHz)	-153	3.3	120	Die
SIPL369ZSP3		0.01~1	0.01~1	1	-106 (Fpd=100MHz, Fout=20GHz)	-153	3.3	120	3*3 QFN-16L

1.4 锁相环芯片

型号	指标	鉴相频率 (MHz)	射频输入频率 (GHz)	归一化闪烁噪声 (dBc/Hz)	噪声 FOM (dBc/Hz)	功耗	芯片/封装尺寸
SIPL446Z <i>(New)</i>		150 (最高)	500 (最高)	-253	-209	6.8mA/3.3V	Die
SIPL219ZASP4	1~200@整数模式	0.2~24@整数模式	-127 (@10kHz) @整数模式	-233@整数模式	120mA/3.3V	4*4 QFN-24L	
	5~150@小数模式	0.2~24@小数模式	/	-228@小数模式			
SIPL219ZA	1~200@整数模式	0.2~24@整数模式	-127 (@10kHz) @整数模式	-233@整数模式	120mA/3.3V	Die	
	5~150@小数模式	0.2~24@小数模式	/	-228@小数模式			
SIPL219ZSP4	1~200@整数模式	0.2~24@整数模式	-127 (@10kHz) @整数模式	-233@整数模式	110mA/3.3V	4*4 QFN-24L	
	5~150@小数模式	0.2~24@小数模式	/	-228@小数模式			
SIPL219Z	1~200@整数模式	0.2~24@整数模式	-127 (@10kHz) @整数模式	-233@整数模式	110mA/3.3V	Die	
	5~150@小数模式	0.2~24@小数模式	/	-228@小数模式			

成都仕芯半导体有限公司

1.5 宽带 VCO

型号	指标	频率范围 (GHz)	输出功率 (dBm)	相位噪声 (dBc/@100KHz)	调谐电压 (V)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	谐波抑制 (dBc)	调谐方式	带 N 分频输出	芯片/封装尺寸
SIV362		10~20	2	-96	0~5	3.5	85	22@2 次谐波 22@3 次谐波	分段式	否	Die
SIV449Z		10~20	6	-90	0~16	5	75	20@2 次谐波 28@3 次谐波	分段式	否	Die
SIV448Z		10~20	6	-90	0~16	5	75	20@2 次谐波 28@3 次谐波	分段式	否	Die
SIV350		20~30	2	-90	0~5	3	70	18@2 次谐波 25@3 次谐波	分段式	否	Die
SIV350SP4		20~30	2	-90	0~5	3	70	18@2 次谐波 25@3 次谐波	分段式	否	4*4 QFN-24L

1.6 对数检波器芯片

型号	指标	RF 频率范围 (GHz)	动态范围 (dB)	上升时间 (ns)	下降时间 (ns)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	输出电压范围 (V)	芯片/封装尺寸
SIPD337		18~40	58	4	8	3.3	120	/	Die
SIPD368ZA		0.003~6	55	10	15	3.3	35	1.0~2.0	Die
SIPD368ZASP3		0.003~6	55	10	15	3.3	35	1.0~2.0	3*3 QFN-16L
SIPD317ZA		0.5~12	54	9	14	3.3	100	0.9~1.8	Die
SIPD317ZASP3		0.5~12	54	9	14	3.3	100	0.9~1.8	3*3 QFN-16L
SIPD285Z		0.5~20	57	9	14	3.3	102	0.9~1.9	Die
SIPD285ZSP3		0.5~20	57	9	14	3.3	102	0.9~1.9	3*3 QFN-16L
SIPD286Z		0.5~23	56	9	16	3.3	100	0.9~1.9	Die
SIPD286ZSP3		0.5~23	56	9	16	3.3	100	0.9~1.9	3*3 QFN-16L

成都仕芯半导体有限公司

1.7 分频器芯片

型号	指标	功能	频率范围 (GHz)	功耗	输出功率 (dBm)	相位噪声 (dBc/Hz) @100KHz (Fout=3GHz)	芯片/封装尺寸
SID184Z		/1, 2, 3, 4 低噪声连续 可编程分频	0.01~15	100mA/3.3V	-1	-156 (N=4)	Die
SID184ZSP4		/1, 2, 3, 4 低噪声连续 可编程分频	0.01~15	100mA/3.3V	-1	-156 (N=4)	4*4 QFN-24L
SID002Z		Div 2/固定分频	DC~35	58mA/3.3V	-1	-153	Die
SID002ZSP3		Div 2/固定分频	DC~35	58mA/3.3V	-1	-153	3*3 QFN-16L
SID003Z		Div 4/固定分频	DC~35	62mA/3.3V	0	-153	Die
SID003ZSP3		Div 4/固定分频	DC~35	62mA/3.3V	0	-153	3*3 QFN-16L
SID004Z		Div 8/固定分频	DC~35	66mA/3.3V	0	-153	Die
SID004ZSP3		Div 8/固定分频	DC~35	66mA/3.3V	0	-153	3*3 QFN-16L
SID005Z		/1, 2, 4, 8 可编程分频	DC~35	48mA/3.3V@N=1 66mA/3.3V@N=8	-1	-153	Die
SID005ZSP3		/1, 2, 4, 8 可编程分频	DC~35	48mA/3.3V@N=1 66mA/3.3V@N=8	-1	-153	3*3 QFN-16L
SID185Z		1~17 可编程分频	DC~10	165mA/3.3V	0	-153 (N=2)	Die
SID185ZSP4		1~17 可编程分频	DC~10	165mA/3.3V	0	-153 (N=2)	4*4 QFN-24L

成都仕芯半导体有限公司

1.8 放大器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	增益 (dB)	饱和功率 (dBm)	噪声系数 (dB)	输出 P1dB (dBm)	IP3 (dBm)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	芯片/封装尺寸
SIA207ZSP2		DC~10	16.5	17.5	3.7	16	25.5	5	65	2*2 QFN-6L
SIA373ZT3		0.05~4	15	21.5	1.6	21.5	40	5	117	SOT89
SIA373Z		0.05~4.5	16	21.5	1.8	21.5	40.5	5	115	Die
SIA372ZT3		0.05~4	23	23	1.3	22	40	5	150	SOT89
SIA372Z		0.05~4.5	23.5	23	1.3	22.5	39	5	140	Die
SIA070Z		0.01~8	14.5	20	2.0	19	32.5	5	62	Die
SIA070ZSP2		0.01~8	14.5	20	2.0	19	32.5	5	62	2*2 QFN-6L
SIA3024ZT3		0.01~3	20	21	1.1	20.5	35	5	80	SOT-89
SIA3024Z		0.01~3	20	21	1.1	20.5	35	5	80	Die
SIA334Z		1~9	25.5	17	0.7	16.5	32	5	59	Die
SIA332ZSP3		1~18	15	18	1.7	17	30	5	46	3*3 QFN-16L
SIA332Z		1~18	15.5	18.5	1.6	17	30	5	42	Die
SIA336ZSP5		1~20	17.5	17	1.9	15.5	27	5	69	5*5 QFN-32L
SIA336Z		1~20	18	17.5	1.9	15.5	27	5	64	Die
SIA339ZSP3		2~11	28	22	1.3	21	35	5	90	3*3 QFN-16L
SIA339Z		2~11	28	22.5	1.4	22	36	5	89	Die
SIA395Z		25M~12	16.5	21.5	2.6	21	37	5	108	Die
SIA395ZSP2		25M~12	16.5	21.5	2.6	21	37	5	108	2*2 QFN-6L
SIA178ZSP3		6~18	24	17	1.4	15.5	29	5	64	3*3 QFN-16L
SIA178Z		6~18	25	17.5	1.2	16	30	5	59	Die

成都仕芯半导体有限公司

1.9 开关芯片

型号	指标	类型	频率范围 (GHz)	插损 (dB)	隔离度 (dB)	回波损耗 (dB)	响应时间 (ns)	控制电压 (V)	电源电压 (V)	芯片/封装尺寸
SIS403Z		单刀双掷	0.1~40	1.9	38	15	20	0~5	5	Die
SIS402Z		单刀单掷	0.1~20	1.0	50	20	45	0~5	5	Die
SIS399Z		单刀单掷	0.1~40	1.2	40	15	45	0~5	5	Die
SIS342ZSP3		单刀双掷	0.01~20	1.3	51	20	27	0~5	-5	3*3 QFN-16L
SIS342Z/SIS342ZM		单刀双掷	0.01~20	1.3	52	23	27	0~5	-5	Die
SIS376SL3		单刀双掷	9kHz~44	1.0	63	15	800	0~3.6	+3.3/-3.3	3*3 LGA-20L
SIS119SL3		单刀双掷	100MHz~44	1.2	60	17	17	0~3.6	+3.3/-3.3	3*3 LGA-20L
SIS313SL3		单刀四掷	9kHz~44	1.6	59	15	400	0~3.6	+3.3/-3.3	3*3 LGA-20L
SIS375SL3		单刀四掷	100MHz~44	1.4	62	15	12	0~3.6	+3.3/-3.3	3*3 LGA-20L
SIS110BSP3		单刀双掷	9kHz~13	0.7	45	21	880	0~3.6	3~5	3*3 QFN-16L
SIS343Z		单刀单掷	9kHz~20	1.0	57	23	24	0~5	-5	Die
SIS383Z		单刀单掷	9kHz~20	1.0	58	23	209	0~5	-5	Die
SIS216ZSP3		单刀双掷	0.01~20	1.3	60	15	15	0~5	3~5	3*3 QFN-16L
SIS216Z		单刀双掷	0.02~20	1.3	60	20	8	0~5	3~5	Die
SIS344ZSP3		单刀四掷	0.1~20	2.0	44	13	25	0~5	5	3*3 QFN-16L
SIS344Z/SIS344ZM		单刀四掷	9kHz~20	1.7	50	17	17	0~5	-5	Die
SIS384Z		单刀四掷	9kHz~20	1.6	50	17	237	0~5	-5	Die
SIS388ZSP3		单刀四掷	0.1~20	2.0	44	13	25	0~5	5	3*3 QFN-16L
SIS388Z		单刀四掷	0.1~20	1.7	51	20	27	0~5	5	Die

注: SISXXX 与 SISXXXM 互为镜像版本。

成都仕芯半导体有限公司

1.10 固定衰减器

型号	指标	频率范围 (GHz)	衰减量 (dB)	功率容量 (W)	衰减容差 (dB)	回波损耗 (dB)	芯片/封装尺寸
SIAT420ZSP2		DC~30	20	2.5	±0.3	20	2*2 DFN-6L
SIAT419ZSP2		DC~30	15	2.5	±0.5	18	2*2 DFN-6L
SIAT320ZSP2		DC~30	0	2.5	±0.5	15	2*2 DFN-6L
SIAT420Z		DC~40	20	2.5	±2	21	Die
SIAT419Z		DC~40	15	2.5	±1	20	Die
SIAT320Z		DC~40	0	2.5	±0.5	20	Die

1.11 数控衰减器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	位数 (bit)	插损 (dB)	衰减精度 (dB)	衰减范围 (dB)	回波损耗 (dB)	工作电压 (V)	芯片/封装尺寸
SIAT379SP5		9kHz~13	7	1.4dB	± (0.25+2%)	31.75	25	3~5	5*5 QFN-32L
SIAT116BSP5		9kHz~13	7	1.4dB	± (0.25+2%)	31.75	25	3~5	5*5 QFN-32L
SIAT347ZSP4		0.1~20	6	2.5	±0.2	0.5~31.5	15	5	4*4 QFN-24L
SIAT347Z		0.1~20	6	2.5	±0.2	0.5~31.5	20	5	Die

1.12 耦合器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	插损 (dB)	耦合度 (dB)	输入回波损耗 (dB)	输出回波损耗 (dB)	耦合端回波损耗 (dB)	隔离度 (dB)	芯片/封装尺寸
SIPS422Z		2~20	1.2	21	-16	-18	-16	38	Die
SIPS423Z		6~18	0.5	15	-15	-15	-15	34	Die
SIPS424Z		10~20	0.5	16	-17	-16	-17	25	Die
SIPS426Z		18~30	0.5	15	-20	-20	-19	27	Die
SIPS427Z		18~30	1.0	10	-26	-23	-22	31	Die

2 检波器芯片

2.1 对数检波器芯片

型号	指标	RF 频率范围 (GHz)	动态范围 (dB)	上升时间 (ns)	下降时间 (ns)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	输出电压范围 (V)	芯片/封装尺寸
SIPD337		18~40	58	4	8	3.3	120	0.8~2.2	Die
SIPD338		0.003~6	55	10	15	3.3	40	0.9~2.1	Die
SIPD338SP3		0.003~6	55	10	15	3.3	40	0.9~2.1	3*3 QFN-16L
SIPD368ZA		0.003~6	55	10	15	3.3	35	1.0~2.0	Die
SIPD368ZASP3		0.003~6	55	10	15	3.3	35	1.0~2.0	3*3 QFN-16L
SIPD368		0.003~6	55	10	15	3.3	40	0.9~2.1	Die
SIPD368SP3		0.003~6	55	10	15	3.3	40	0.9~2.1	3*3 QFN-16L
SIPD319		0.5~8	54	9	13	3.3	49	0.6~1.45	Die
SIPD319SP3		0.5~8	54	9	13	3.3	49	0.6~1.45	3*3 QFN-16L
SIPD317ZA		0.5~12	54	9	14	3.3	100	0.9~1.8	Die
SIPD317ZASP3		0.5~12	54	9	14	3.3	100	0.9~1.8	3*3 QFN-16L
SIPD317		0.5~10	61	9	14	3.3	60	0.7~1.6	Die
SIPD317SP3		0.5~10	61	9	14	3.3	60	0.7~1.6	3*3 QFN-16L
SIPD316		0.5~12	67	9	14	3.3	86	1.0~1.95	Die
SIPD316SP3		0.5~12	67	9	14	3.3	86	1.0~1.95	3*3 QFN-16L
SIPD318		0.5~12	60	9	14	3.3	75	0.65~1.55	Die
SIPD318SP3		0.5~12	60	9	14	3.3	75	0.65~1.55	3*3 QFN-16L
SIPD285Z		0.5~20	57	9	14	3.3	102	0.9~1.9	Die
SIPD285ZSP3		0.5~20	57	9	14	3.3	102	0.9~1.9	3*3 QFN-16L
SIPD285		0.5~20	60	9	14	3.3	78	0.7~1.6	Die
SIPD285SP3		0.5~20	60	9	14	3.3	78	0.7~1.6	3*3 QFN-16L
SIPD286Z		0.5~23	56	9	16	3.3	100	0.9~1.9	Die
SIPD286ZSP3		0.5~23	56	9	16	3.3	100	0.9~1.9	3*3 QFN-16L
SIPD286		0.5~23	65	9	16	3.3	87	1.15~1.95	Die
SIPD286SP3		0.5~23	65	9	16	3.3	87	1.15~1.95	3*3 QFN-16L

成都仕芯半导体有限公司

3 锁相环芯片

3.1 频综芯片

指标 型号	频率范围 (GHz)	归一化噪底 (dBc/Hz)	最高鉴相频率 (MHz)	VCO 基频 (GHz)	相位噪声@10kHz (dBc/Hz)	工作电压 (V)	芯片/封装尺寸
SIPL447Z (New)	0.005~0.4	-230	200	/	-131@100MHz	3.3	Die
SIPL450ZSP5 (New)	0.03~7.5	-228@整数模式 -225@小数模式	10~100@整数模式 10~100@小数模式	3.75~7.5	-104@3.8GHz	3.3	5*5 QFN-32L
SIPL452SP6	0.078125~20	-232@整数模式 -227@小数模式	10~200@整数模式 10~100@小数模式	10~20	-100@20GHz	3.3	6*6 QFN-40L
SIPL457SP6	0.078125~20	-232@整数模式 -229@小数模式	10~200@整数模式 10~100@小数模式	10~20	-100@20GHz	3.3	6*6 QFN-40L
SIPL351SP6	0.078125~20	-235@整数模式 -230@小数模式	2~200@整数模式 2~50@小数模式	10~20	-101@20GHz	3.3	6*6 QFN-40L
SIPL364SP6	0.9375~15	-235@整数模式 -230@小数模式	2~200@整数模式 2~50@小数模式	7.5~15	-101@15GHz	3.3	6*6 QFN-40L
SITR229ASP4C	23~25	-230@整数模式	5~200@整数模式 5~150@小数模式	23~25	-92@24.8GHz	3.3	4*4 QFN-32L

3.2 鉴相器芯片

指标 型号	鉴相频率 (GHz)	射频输入频率 (GHz)	射频分频数	相位噪声 (dBc/Hz) @100KHz	归一化底噪 (dBc/Hz)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	芯片/封装尺寸
SIPL187ZSP5	0.1~1	0.2~20	12~2048	-108 (Fpd=100MHz, Fout=20GHz)	-236	3.3	250	5*5 QFN-32L
SIPL369Z	0.01~2	0.01~2	1	-106 (Fpd=100MHz, Fout=20GHz)	-153	3.3	120	Die
SIPL369ZSP3	0.01~1	0.01~1	1	-106 (Fpd=100MHz , Fout=20GHz)	-153	3.3	120	3*3 QFN-16L
SIPL186ASP3	0.01~2	0.01~2	1	/	-151	3.3	124	3*3 QFN-16L
SIPL186	0.01~2	0.01~2	1	/	-151	3.3	124	Die
SIPL186SP3	0.01~2	0.01~2	1	/	-151	3.3	124	3*3 QFN-16L

成都仕芯半导体有限公司

3.3 小数分频锁相环芯片

型号 \ 指标	鉴相频率 (MHz)	射频输入频率 (GHz)	归一化闪烁噪声 (dBc/Hz)	噪声 FOM (dBc/Hz)	功耗	芯片/封装尺寸
<u>SIPL446Z (New)</u>	150 (最高)	500 (最高)	-253	-209	6.8mA/3.3V	Die
SIPL365ASP4	1~300@整数模式	0.1~12@整数模式	-128 (@10kHz) @整数模式	-233@整数模式	130mA/3.3V	4*4 QFN-24L
	5~150@小数模式	0.2~12@小数模式	/	-228@小数模式		
SIPL219ZASP4	1~200@整数模式	0.2~24@整数模式	-127 (@10kHz) @整数模式	-233@整数模式	120mA/3.3V	4*4 QFN-24L
	5~150@小数模式	0.2~24@小数模式	/	-228@小数模式		
SIPL219ZA	1~200@整数模式	0.2~24@整数模式	-127 (@10kHz) @整数模式	-233@整数模式	120mA/3.3V	Die
	5~150@小数模式	0.2~24@小数模式	/	-228@小数模式		
SIPL219A	1~300@整数模式	0.1~24@整数模式	-131 (@10kHz) @整数模式	-235@整数模式	130mA/3.3V	Die
	5~150@小数模式	0.2~24@小数模式	/	-230@小数模式		
SIPL219ASP4	1~300@整数模式	0.1~24@整数模式	-131 (@10kHz) @整数模式	-235@整数模式	130mA/3.3V	4*4 QFN-24L
	5~150@小数模式	0.2~24@小数模式	/	-230@小数模式		
SIPL219ZSP4	1~200@整数模式	0.2~24@整数模式	-127 (@10kHz) @整数模式	-233@整数模式	110mA/3.3V	4*4 QFN-24L
	5~150@小数模式	0.2~24@小数模式	/	-228@小数模式		
SIPL219Z	1~200@整数模式	0.2~24@整数模式	-127 (@10kHz) @整数模式	-233@整数模式	110mA/3.3V	Die
	5~150@小数模式	0.2~24@小数模式	/	-228@小数模式		
SIPL219	1~300@整数模式	0.1~26@整数模式	-127 (@10kHz) @整数模式	-235@整数模式	130mA/3.3V	Die
	5~150@小数模式	0.2~18@小数模式	/	-227@小数模式		
SIPL219SP4	1~300@整数模式	0.1~26@整数模式	-127 (@10kHz) @整数模式	-235@整数模式	130mA/3.3V	4*4 QFN-24L
	5~150@小数模式	0.2~18@小数模式	/	-227@小数模式		

4 电调延时器芯片

4.1 模拟电调延时器芯片

型号 \ 指标	频率范围 (GHz)	延时调节范围 (ps)	输出功率 (dBm)	输入阻抗 (Ω)	输出阻抗 (Ω)	输出回波损耗 (dB)	电源电压 (V)	工作电流 (mA)	芯片/封装尺寸
<u>SIDL468ZSP4C (New)</u>	DC~5	100	7	100	100	11	3.3	270	4*4 QFN-32L
<u>SIDL478ZSP4C (New)</u>	DC~5	200	7	100	100	11	3.3	250	4*4 QFN-32L

成都仕芯半导体有限公司

5 VCO 芯片

5.1 窄带 VCO 芯片

型号	指标 频率范围 (GHz)	输出功率 (dBm)	相位噪声 (dBc/@100KHz)	调谐电压 (V)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	谐波抑制 (dBc)	N 分频输出	频率温飘 (MHz/°C)	芯片/封装尺寸
SIV296SP4	3.9~4.45	8	-112	0~10	3.3	27	22@2 次谐波 14@3 次谐波	/	0.4	4*4 QFN-24L
SIV6019SP5	5.3~6.04	7.5	-114	0.3~4.5	5	145	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	5*5 QFN-32L
SIV6020SP5	5.87~6.975	7.5	-114	0.3~4.5	5	145	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	5*5 QFN-32L
SV5501SP4	6.71~7.7	8.5	-116	0~4.8	5	145	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SV5502SP4	7.31~8.36	8	-115	0~4.8	5	143	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SV5506SP4	7.84~8.9	8	-113	0~4.8	5	143	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SV5504SP4	8.44~9.3	7.5	-113	0~4.8	5	143	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SV5507SP4	8.44~9.5	8	-113	0~4.8	5	143	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SV5509SP4	8.94~9.94	7.5	-113	0~4.8	5	143	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SIV007SP4	8.5~10	8	-111	0~5	5	129	60@1/2 次谐波 60@3/2 次谐波	/4	1	4*4 QFN-24L
SV5518SP4	9.26~10.2	7.5	-113	0~4.8	5	143	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SV5510SP4	9.44~10.3	7.5	-113	0~4.8	5	143	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SV5517SP4	9.98~10.9	7.5	-111	0~4.8	5	150	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SV5511SP4	10.25~11.5	8	-112	0~4.8	5	145	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SV5505SP4	10.85~11.65	8	-111	0~4.8	5	145	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SIV099SP5	11.035~12.02	13	-113	2~13	5	190	23@1/2 次谐波 20@3/2 次谐波	/2	1	5*5 QFN-32L
SV5513SP4	11.02~12.16	7.5	-112	0~4.8	5	145	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L

成都仕芯半导体有限公司

型号	指标 频率范围 (GHz)	输出功率 (dBm)	相位噪声 (dBc/@100KHz)	调谐电压 (V)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	谐波抑制 (dBc)	N 分频输出	频率温飘 (MHz/°C)	芯片/封装尺寸
SV5514SP4	11.68~12.7	7.5	-111	0~4.8	5	145	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SIV097SP5	11.5~12.8	12	-113	2~13	5	190	20@1/2 次谐波 24@3/2 次谐波	/2	1	5*5 QFN-32L
SIV093SP5	12.17~13.33	12	-112	2~13	5	190	22@1/2 次谐波 25@3/2 次谐波	/2	1	5*5 QFN-32L
SV5516SP4	12.56~13.6	7	-109	0~4.8	5	145	45@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SIV094SP5	12.47~13.9	12	-112	2~13	5	190	22@1/2 次谐波 25@3/2 次谐波	/2	1	5*5 QFN-32L
SV5515SP4	13.5~14.6	7.5	-111	0~4.8	5	145	35@1/2 次谐波 30@3/2 次谐波	/2	1	4*4 QFN-24L
SIV096SP5	13.6~14.9	11	-111	2~13	5	190	30@1/2 次谐波 30@3/2 次谐波	/2	1	5*5 QFN-32L
SIV008SP4	19.5~22.5	5.5	-104	0~5	5	140	30@1/2 次谐波 35@3/2 次谐波	/8	2	4*4 QFN-24L
SIV101	21~24	4	-103	0~5	5	110	46@1/2 次谐波 43@3/2 次谐波	/8	2	Die
SIV101SP4	21~24	4	-103	0~5	5	110	46@1/2 次谐波 43@3/2 次谐波	/8	2	4*4 QFN-24L
SIV092SP4	23.8~24.8	12	-96	2~13	5	125	25@1/2 次谐波 35@3/2 次谐波	/8	2	4*4 QFN-24L
SIV009SP4	23.5~26.8	5	-102	0~5	5	148	30@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	/8	2.55	4*4 QFN-24L
SIV025	24.5~28.5	1.5	-102	0~5	5	128	30@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	单段连续 式	是	Die
SIV025SP4	24.5~28.5	1.5	-102	0~5	5	128	30@1/2 次谐波 40@3/2 次谐波	单段连续 式	是	4*4 QFN-24L

成都仕芯半导体有限公司

5.2 宽带 VCO 芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	输出功率 (dBm)	相位噪声 (dBc/@100KHz)	调谐电压 (V)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	谐波抑制 (dBc)	调谐方式	带 N 分频输出	芯片/封装尺寸
SIV362		10~20	2	-96	0~5	3.5	85	22@2 次谐波 22@3 次谐波	分段式	否	Die
SIV449Z		10~20	6	-90	0~16	5	75	20@2 次谐波 28@3 次谐波	分段式	否	Die
SIV448Z		10~20	6	-90	0~16	5	75	20@2 次谐波 28@3 次谐波	分段式	否	Die
SIV350		20~30	2	-90	0~5	3	70	18@2 次谐波 25@3 次谐波	分段式	否	Die
SIV350SP4		20~30	2	-90	0~5	3	70	18@2 次谐波 25@3 次谐波	分段式	否	4*4 QFN-24L
SIV103		0.625~10	5	-106	0~5	5	103	25@2 次谐波 20@3 次谐波	分段式	否	Die
SIV103SP4		0.625~10	5	-106	0~5	5	103	25@2 次谐波 20@3 次谐波	分段式	否	4*4 QFN-24L
SIV023SP4		6~12	13	-98	0~23	5	70	12@2 次谐波 20@3 次谐波	单段连续式	否	4*4 QFN-24
SIV021SP4		8~16	12	-92	0~23	5	70	15@2 次谐波 25@3 次谐波	单段连续式	否	4*4 QFN-24L
SIV019SP4		8~16	7	-103	0~5	5	138	28@1/2 次谐波 30@3/2 次谐波 26@2 次谐波 40@3 次谐波	分段式	是	4*4 QFN-24L
SIV018SP4		8.5~17	7	-101	0~5	5	136	28@1/2 次谐波 30@3/2 次谐波 26@2 次谐波 40@3 次谐波	分段式	是	4*4 QFN-24L
SIV022SP4		10~20	8	-88	0~23	5	60	15@2 次谐波 25@3 次谐波	单段连续式	否	4*4 QFN-24L
SIV100		10~20	8	-101	0~5	5	162	36@1/2 次谐波 30@3/2 次谐波 22@2 次谐波 33@3 次谐波	分段式	是	Die
SIV100SP4		10~20	8	-101	0~5	5	162	36@1/2 次谐波 30@3/2 次谐波 22@2 次谐波 33@3 次谐波	分段式	是	4*4 QFN-24L

6 分频器芯片

6.1 可编程分频器芯片

型号	指标	功能	频率范围 (GHz)	功耗	输出功率 (dBm)	相位噪声 (dBc/Hz) @100KHz	芯片/封装尺寸
SID185Z		1~17 可编程分频	DC~10	165mA/3.3V	0	-153 (N=2)	Die
SID185ZSP4		1~17 可编程分频	DC~10	165mA/3.3V	0	-153 (N=2)	4*4 QFN-24L
SID185A		1~17 可编程分频	DC~8	157mA/3.3V	0	-157 (N=2)	Die
SID185ASP4		1~17 可编程分频	DC~8	157mA/3.3V	0	-157 (N=2)	4*4 QFN-24L
SID184Z		/1, 2, 3, 4 低噪声连续可编程分频	0.01~15	100mA/3.3V	-1	-156 (N=4)	Die
SID184ZSP4		/1, 2, 3, 4 低噪声连续可编程分频	0.01~15	100mA/3.3V	-1	-156 (N=4)	4*4 QFN-24L
SID184A		/1, 2, 3, 4 低噪声连续可编程分频	0.001~15	118mA/3.3V	0@单端输出	-158 (N=4)	Die
SID184ASP3		/1, 2, 3, 4 低噪声连续可编程分频	0.001~15	118mA/3.3V	0@单端输出	-158 (N=4)	3*3 QFN-16L
SID027SP3		/1, 2, 4, 8 可编程分频	DC~21	30mA/3.3V@N=1 43mA/3.3V@N=8	-2	-153	3*3 QFN-16L
SID182A		1、2、4、8、16、32、64、128 可编程分频	DC~26	101	1	-156 (N=2)	Die
SID182ASP3		1、2、4、8、16、32、64、128 可编程分频	DC~26	101	1	-156 (N=2)	3*3 QFN-16L
SID005Z		/1, 2, 4, 8 可编程分频	DC~35	48mA/3.3V@N=1 66mA/3.3V@N=8	-1	-153	Die
SID005ZSP3		/1, 2, 4, 8 可编程分频	DC~35	48mA/3.3V@N=1 66mA/3.3V@N=8	-1	-153	3*3 QFN-16L
SID005		/1, 2, 4, 8 可编程分频	DC~30	32mA/3.3V@N=1 45mA/3.3V@N=8	-2	-154	Die
SID005SP3		/1, 2, 4, 8 可编程分频	DC~30	32mA/3.3V@N=1 45mA/3.3V@N=8	-2	-154	3*3 QFN-16L

6.2 固定分频器芯片

型号	指标	功能	频率范围 (GHz)	功耗 (mA)	输出功率 (dBm)	相位噪声 (dBc/Hz) @100KHz	芯片/封装尺寸
SID180		Div 3/固定分频	0.1~15	65mA/3.3V	0~2	-159 (Fout=2GHz)	Die
SID180SP3		Div 3/固定分频	0.1~15	65mA/3.3V	0~2	-159 (Fout=2GHz)	3*3 QFN-16L
SID181A		Div 5/固定分频	DC~15	72mA/3.3V	0.5	-161 (Fin=6GHz)	Die
SID181ASP3		Div 5/固定分频	DC~15	72mA/3.3V	0.5	-161 (Fin=6GHz)	3*3 QFN-16L
SID002Z		Div 2/固定分频	DC~35	58mA/3.3V	-1	-153	Die
SID002ZSP3		Div 2/固定分频	DC~35	58mA/3.3V	-1	-153	3*3 QFN-16L
SID002		Div 2/固定分频	DC~30	36mA/3.3V	-5.1~1.2	-154	Die
SID002SP3		Div 2/固定分频	DC~30	36mA/3.3V	-5.1~1.2	-154	3*3 QFN-16L
SID003Z		Div 4/固定分频	DC~35	62mA/3.3V	0	-153	Die
SID003ZSP3		Div 4/固定分频	DC~35	62mA/3.3V	0	-153	3*3 QFN-16L
SID003		Div 4/固定分频	DC~30	39mA/3.3V	-4.3~1.4	-154	Die
SID003SP3		Div 4/固定分频	DC~30	39mA/3.3V	-4.3~1.4	-154	3*3 QFN-16L
SID004Z		Div 8/固定分频	DC~35	66mA/3.3V	0	-153	Die
SID004ZSP3		Div 8/固定分频	DC~35	66mA/3.3V	0	-153	3*3 QFN-16L
SID004		Div 8/固定分频	DC~30	40mA/3.3V	-4.3~1.2	-153	Die
SID004SP3		Div 8/固定分频	DC~30	40mA/3.3V	-4.3~1.2	-153	3*3 QFN-16L

7 梳状谱发生器芯片

7.1 奇数次梳状谱发生器芯片

型号	指标	五次谐波输出功率 (fin=100MHz) (dBm)	十一谐波输出功率 (fin=100MHz) (dBm)	二十三谐波输出功率 (fin=100MHz) (dBm)	五次谐波输出功率 (fin=1GHz) (dBm)	十一谐波输出功率 (fin=1GHz) (dBm)	二十一次谐波输出功率 (fin=1GHz) (dBm)	相邻偶次波抑制 (dBm)	相位噪声@频偏 100KHz (dBc/Hz)	芯片/封装尺寸
SICG256		-16	-22	-34	-7	-18	-32	20	-180	Die
SICG256SP3		-16	-22	-34	-7	-18	-32	20	-180	3*3 QFN-16L

7.2 连续梳状谱发生器芯片

型号	指标	五次谐波输出功率 (fin=100MHz) (dBm)	十一谐波输出功率 (fin=100MHz) (dBm)	二十三谐波输出功率 (fin=100MHz) (dBm)	五次谐波输出功率 (fin=1GHz) (dBm)	十一谐波输出功率 (fin=1GHz) (dBm)	二十一次谐波输出功率 (fin=1GHz) (dBm)	相位噪声@频偏 100KHz (dBc/Hz)	芯片/封装尺寸
SICG370ZSP4		/	/	/	-5.5	-14	-16	-170	4*4 QFN-24L
SICG370Z		/	/	/	-5.5	-14	-16	-170	Die

成都仕芯半导体有限公司

SICG257	-20	-30	-40	-13	-23	-25	-180	Die
SICG257SP3	-20	-30	-40	-13	-23	-25	-180	3*3 QFN-16L

8 混频器芯片

8.1 无源 IQ 混频器芯片

型号	指标	RF 频率范围 (GHz)	本振频率范围 (GHz)	中频频率范围 (GHz)	本振驱动功率 (dBm)	变频损耗 (dB)	LO-RF 隔离度 (dB)	输入 IP3 (dBm)	镜像抑制度 (dB)	输入 P1dB (dBm)	芯片/封装尺寸
SIM211		8~16	8~16	DC~3.5	15~21	9	45	19	24	15	Die
SIM211SP4		8~16	8~16	DC~3.5	15~21	9	45	19	24	15	4*4 QFN-24L

8.2 无源混频器芯片

型号	指标	RF 频率范围 (GHz)	LO 频率范围 (GHz)	中频频率范围 (GHz)	LO 驱动功率 (dBm)	变频损耗 (dB)	LO-RF 隔离度 (dB)	LO-IF 隔离度 (dB)	RF-IF 隔离度 (dB)	输入 P1dB (dBm)	输入 IP3 (dBm)	芯片/封装尺寸
SIM442ZSP5D		1.3~2.7	1.7~2.5	0.005~0.5	-6~6	6	33	32	20	11	25.5	5*5 QFN-20L
SIM444ZSP23		2~20	1~20	DC~6	-3~6	8.5	40	40	38	17	21.4	2*3 QFN-12L
SIM445ZSP23		2~20	1~20	0.5~9	-3~6	9.8	40	35	40	17	23	2*3 QFN-12L
SIM287ZSP23		2~14	1~12	0.5~6	-6~6	8.8	55	40	45	18	25.5	2*3 QFN-12L
SIM295ZSP23		2~14	1~12	DC~6	-6~6	7.4	45	45	44	18	22.8	2*3 QFN-12L
SIM273		0.6~2	0.6~2	DC~1	13~21	7.5	52	42	16	12	20	Die
SIM273SP3B		0.6~2	0.6~2	DC~1	13~21	7.5	52	42	16	12	20	3*3 QFN-12L
SIM331		1.5~4.5	1.5~4.5	DC~1.5	11~15	7.5	56	37	19	12	21	Die
SIM331SP3B		1.5~4.5	1.5~4.5	DC~1.5	11~15	7.5	56	37	19	12	21	3*3 QFN-12L
SIM355C8		1.8~4.5	1.8~4.5	0.1~2	12~18	8	38	36	19	10	19	CSOP-8L
SIM8002SP3B		1.8~6	1.8~6	DC~2	13~19	8.5	55	35	25	12	20.5	3*3 QFN-12L
SIM086SP3B		2.5~8	2.5~8	DC~3	13~19	8.5	48	25	18	12	25	3*3 QFN-12L
SIM086		3~9	3~9	DC~3	13~19	7	48	32	13	12	25	Die
SIM221SP3B		3~10	3~10	DC~4	13~21	9	47	42	26	17.5	26	3*3 QFN-12L
SIM221		3~11	3~11	DC~4.5	13~21	9.5	48	45	24	16	26	Die
SIM8004		6~18	6~18	DC~6	13~19	9	45	35	22	12	24	Die
SIM275SP3B		4~22	4~22	DC~3	9~19	9	53	25	33	10.5	19	3*3 QFN-12L
SIM275/275M		3.5~24	3.5~24	DC~4	11~17	9	53	25	33	10.5	21	Die

成都仕芯半导体有限公司

型号	指标 RF 频率范围 (GHz)	LO 频率范围 (GHz)	中频频率范围 (GHz)	LO 驱动功率 (dBm)	变频损耗 (dB)	LO-RF 隔离度 (dB)	LO-IF 隔离度 (dB)	RF-IF 隔离度 (dB)	输入 P1dB (dBm)	输入 IP3 (dBm)	芯片/封装尺寸
SIM303/303M	4.5~24	4.5~24	DC~4	16~21	9.5	53	28	33	16	27.7	Die
SIM276SP3B	6~23	6~23	DC~7	13~19	8.5	48	30	34	/	18.5	3*3 QFN-12L
SIM304/304M	6~26.5	6~26.5	DC~9	16~21	8.5	48	30	35	15	25	Die
SIM305SP3B	6~26.5	6~26.5	DC~9	11~16	8.5	47	30	36	10.5	20	3*3 QFN-12L
SIM276/276M	6~27	6~27	DC~9	11~17	8.5	46	28	34	11	21	Die
SIM305/305M	8~30	8~30	DC~10.5	11~16	8.5	44	27	34	10.5	21	Die
SIM306/306M	8~30	8~30	DC~10.5	16~21	8.5	45	31	32	15.5	26	Die
SIM349/349M	10~40	10~40	DC~12	11~15	9.5	50	24	33	6.5	16.5	Die
SIM277/277M	18~50	18~50	DC~20	10~14	10	45	24	42	6	17	Die

注: SIMXXX 与 SIMXXM 互为镜像版本。

8.3 带本振驱动混频器芯片

型号	指标 RF/LO 频率范围 (GHz)	中频频率范围 (GHz)	本振驱动功率 (dBm)	变频损耗 (dB)	LO-RF 隔离度 (dB)	LO-IF 隔离度 (dB)	输入 P1dB (dBm)	输入 IP3 (dBm)	芯片/封装尺寸
<u>SIM8010Z/8010ZM (New)</u>	2.5~7	DC~3	0~8	8.5	35	32	14	22	Die
<u>SIM8009Z (New)</u>	1.8~7	DC~2.5	0~8	9	35	28	15	23	Die
SIM8008ZSP4	2.5~7	DC~3	2~8	8.5	29	28	20	24	4*4 QFN-24L
SIM8008Z	2.5~7	DC~3	2~8	8.5	29	33	19	24	Die
SIM8010SP4B	2.5~7	DC~3	0~8	7	34	27	4	22	4*4 QFN-16L

8.4 有源混频器芯片

型号	指标 输入频率范围 (GHz)	本振频率范围 (GHz)	输出频率范围 (GHz)	本振功率范围 (dBm)	变频增益 (dB)	噪声系数 (dB)	输入驻波 (dB)	输入 P1dB (dBm)	芯片/封装尺寸
SIM195ASP2C	0.01~7	0.001~9	DC~7	-6~6	5.1@Fout=0.9GHz	9.4	13	3.9	2*2 QNF-10L
SIM195SP2C	0.01~7	LF~9	DC~7	-6~6	5.1@Fout=0.9GHz	9.4	13	3.9	2*2 QNF-10L

9 下变频器芯片

9.1 IQ 下变频器芯片

型号	指标	RF 频率范围 (GHz)	本振频率范围 (GHz)	中频频率范围 (GHz)	LO 驱动功率 (dBm)	变频增益 (dB)	LO-RF 隔离度 (dB)	噪声系数 (dB)	镜像抑制 (dBc)	输出 P1dB (dBm)	芯片/封装尺寸
SIDC135SP4		17.5~21.5	7.25~12.5	DC~3.5	2~8	15	45	2.3	23	-8	4*4 QFN-24L
SIDC136SP4		21~24	8.4~13.5	DC~3.5	2~8	14.5	50	2.5	24	-8.5	4*4 QFN-24L
SIDC137SP4		21~27	8.3~15	DC~3.5	2~8	12	45	2.3	18	-8	4*4 QFN-24L
SIDC138SP4		21~30	9~14	DC~3.5	2~8	12	45	2.5	18	-8	4*4 QFN-24L

10 功分器芯片

10.1 一分二功分器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	插损 (dB)	最大输入功率 (W)	输入/输出驻波 (dB)	幅度不平衡 (dB)	相位不平衡 (°)	隔离度 (dB)	芯片/封装尺寸
SIPS202		0.5~2.5	1	2	15	0.1	0.7	18	Die
SIPS202SP4		0.5~2.5	1	2	15	0.1	1	18	4*4 QFN-24L
SIPS123SP4		1.8~12.5	0.8~1.8	2.5	17	<0.5	<5	25@7.5GHz	4*4 QFN-24L
SIPS121SP4		2~25	0.8~2.4	3	17	<0.3	<5	21@12.5GHz	4*4 QFN-24L

10.2 耦合器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	插损 (dB)	耦合度 (dB)	输入回波损耗 (dB)	输出回波损耗 (dB)	耦合端回波损耗 (dB)	隔离度 (dB)	芯片/封装尺寸
<u>SIPS203 (New)</u>		3~19	1.0~1.7	17~24	23	20	20	20	Die
<u>SIPS203SP4 (New)</u>		3~19	1.0~1.7	17~24	23	20	20	20	4*4 QFN-24L
SIPS422Z		2~20	1.2	21	-16	-18	-16	38	Die
SIPS423Z		6~18	0.5	15	-15	-15	-15	34	Die
SIPS424Z		10~20	0.5	16	-17	-16	-17	25	Die
SIPS426Z		18~30	0.5	15	-20	-20	-19	27	Die
SIPS427Z		18~30	1.0	10	-26	-23	-22	31	Die

11 衰减器芯片

11.1 数控衰减器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	位数 (bit)	插损 (dB)	衰减精度 (dB)	衰减范围 (dB)	回波损耗 (dB)	工作电压 (V)	芯片/封装尺寸
SIAT379SP5		9kHz~13	7	1.4dB	± (0.25+2%)	31.75	25	3~5	5*5 QFN-32L
SIAT116BSP5		9kHz~13	7	1.4dB	± (0.25+2%)	31.75	25	3~5	5*5 QFN-32L
SIAT347ZSP4		0.1~20	6	2.5	±0.2	0.5~31.5	15	5	4*4 QFN-24L
SIAT347Z		0.1~20	6	2.5	±0.2	0.5~31.5	20	5	Die
SIAT049SP4		DC~3	6	1.7	±0.2+1%	31.5	15	-5/3.3	4*4 QFN-24L
SIAT047A		DC~3	6	1.5	±0.2+1%	31.5	15	-5	Die
SIAT081SP3		0.1~6	1	0.45@0.1GHz~2GHz 0.5@2GHz~4GHz 0.8@4GHz~6GHz	-0.5~1@0.2GHz~1GHz -1.5~2@1GHz~5GHz -0.5~2@5GHz~6GHz	32.5	15	3	3*3 QFN-16L
SIAT083SP4		0.1~6	6	0.5@0.1GHz~2GHz 0.9@2GHz~4GHz 1.4@4GHz~6GHz	-0.5~1@0.2GHz~6GHz	0.5~31.5	20	3	4*4 QFN-24L
SIAT082SP4		0.1~8	7	0.5dB@0.1~2GHz 0.9dB@2GHz~4GHz 1.4dB@4GHz~6GHz 1.7dB@6GHz~8GHz	1.6	31.75	14	3	4*4 QFN-24L
SIAT116ASP5		DC~13	7	0.7dB@10KHz~10MHz 1.4dB@10MHz~8GHz 2.0dB@8GHz~13GHz	± (0.6+6%)	31.75	15	3~5	5*5 QFN-32L
SIAT046A		DC~15	6	2.4dB@DC~4GHz 3.0dB@4GHz~8GHz 4.0dB@8GHz~13GHz	± (0.2+10%)	31.5	12	-5	Die
SIAT046ASP3		DC~15	6	2.5dB@DC~8.5GHz 3.2dB@8.5GHz~15GHz	2.3	31.5	15	-5	3*3 QFN-16L
SIAT044ASP4		DC~35	5	3.5dB@DC~20GHz 5.0dB@20GHz~32GHz 7.0dB@32GHz~35GHz	2.3	31	12	-5	4*4 QFN-24L
SIAT044A		DC~40	5	4.0dB@DC~20GHz 5.0dB@20GHz~30GHz 5.6dB@30GHz~40GHz	± (0.2+8%)	31	15	-5	Die
SIAT035A		DC~40	1	0.8dB@DC~15GHz 1.1dB@15GHz~20GHz 1.3dB@20GHz~40GHz	± (0.2+10%)	10	14	-5	Die

成都仕芯半导体有限公司

11.2 固定衰减器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	衰减量 (dB)	功率容量 (W)	衰减容差 (dB)	回波损耗 (dB)	芯片/封装尺寸
SIAT420ZSP2		DC~30	20	2.5	±0.3	20	2*2 DFN-6L
SIAT420Z		DC~40	20	2.5	±2	21	Die
SIAT419ZSP2		DC~30	15	2.5	±0.5	18	2*2 DFN-6L
SIAT419Z		DC~40	15	2.5	±1	20	Die
SIAT320ZSP2		DC~30	0	2.5	±0.5	15	2*2 DFN-6L
SIAT320Z		DC~40	0	2.5	±0.5	20	Die
SIAT151SP2		DC~25	1	2.5	±0.25	18	2*2 DFN-6L
SIAT152SP2		DC~25	2	2.5	±0.25	18	2*2 DFN-6L
SIAT153SP2		DC~25	3	2.5	±0.25	18	2*2 DFN-6L
SIAT154SP2		DC~25	4	2.5	±0.30	18	2*2 DFN-6L
SIAT155SP2		DC~25	5	2.5	±0.30	18	2*2 DFN-6L
SIAT156SP2		DC~25	6	2.5	±0.35	18	2*2 DFN-6L
SIAT157SP2		DC~25	7	2.5	±0.35	18	2*2 DFN-6L
SIAT158SP2		DC~25	8	2.5	±0.35	18	2*2 DFN-6L
SIAT150SP2		DC~25	10	2.5	±0.35	18	2*2 DFN-6L
SIAT151		DC~40	1	2.5	±0.3	21	Die
SIAT152		DC~40	2	2.5	±0.3	21	Die
SIAT153		DC~40	3	2.5	±0.3	21	Die
SIAT154		DC~40	4	2.5	±0.3	21	Die
SIAT155		DC~40	5	2.5	±0.2@0~25GHz ±0.4@25~40GHz	21	Die
SIAT156		DC~40	6	2.5	±0.2@0~25GHz ±0.4@25~40GHz	21	Die
SIAT157		DC~40	7	2.5	±0.3@0~25GHz ±0.4@25~40GHz	21	Die
SIAT158		DC~40	8	2.5	±0.2@0~25GHz ±0.6@25~40GHz	21	Die
SIAT150		DC~40	10	2.5	±0.2@0~25GHz ±0.6@25~40GHz	21	Die

11.3 温补衰减器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	插损 (dB)	衰减补偿范围 (dB)	温度补偿范围 (°C)	输入 P1dB (dBm)	输入输出回波 (dB)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	芯片/封装尺寸
SIAT459 (New)		DC~20	2.6	2.5	-55~+125	30	-20	4.8	1.0	Die
SIAT460 (New)		1.5~20	2.6	2.5	-55~+125	30	-20	4.8	1.0	Die
SIAT461 (New)		DC~20	4	3.5	-55~+125	30	-20	4.8	1.0	Die
SIAT462 (New)		1.5~20	4	3.5	-55~+125	30	-20	4.8	1.0	Die

12 放大器芯片

12.1 低噪声放大器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	增益 (dB)	饱和功率 (dBm)	噪声系数 (dB)	输出 P1dB (dBm)	输出 IP3 (dBm)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	芯片/封装尺寸
<u>SIA340Z (New)</u>		8~15	22	21.5	1.4	21	30	5	83	Die
SIA373ZT3		0.05~4	15	21.5	1.6	21.5	40	5	117	SOT89
SIA373Z		0.05~4.5	16	21.5	1.8	21.5	40.5	5	115	Die
SIA372ZT3		0.05~4	23	23	1.3	22	40	5	150	SOT89
SIA372Z		0.05~4.5	23.5	23	1.3	22.5	39	5	140	Die
SIA070Z		0.01~8	14.5	20	2.0	19	32.5	5	62	Die
SIA070ZSP2		0.01~8	14.5	20	2.0	19	32.5	5	62	2*2 QFN-6L
<u>SIA334ZSP3 (New)</u>		1~9	25	16	0.7	15.5	28	5	62	3*3 QFN-16L
SIA334Z		1~9	25.5	17	0.7	16.5	32	5	59	Die
SIA332ZSP3		1~18	15	18	1.7	17	30	5	46	3*3 QFN-16L
SIA332Z		1~18	15.5	18.5	1.6	17	30	5	42	Die
SIA336ZSP5		1~20	17.5	17	1.9	15.5	27	5	69	5*5 QFN-32L
SIA336Z		1~20	18	17.5	1.9	15.5	27	5	64	Die
SIA339ZSP3		2~11	28	22	1.3	21	35	5	90	3*3 QFN-16L
SIA339Z		2~11	28	22.5	1.4	22	36	5	89	Die
SIA395ZSP2		25M~12	16.5	21.5	2.6	21	37	5	108	2*2 QFN-6L
SIA395Z		25M~12	16.5	21.5	2.6	21	37	5	108	Die
SIA178ZSP3		6~18	24	17	1.4	15.5	29	5	64	3*3 QFN-16L
SIA178Z		6~18	25	17.5	1.2	16	30	5	59	Die
SIA209		0.5~1.8	17.4	-	1.25	17	29	5	37	Die
<u>SIA3024ZSP3 (New)</u>		0.01~3	20	21	1.1	20.5	35	5	80	3*3 QFN-16L
SIA3024ZT3		0.01~3	20	21	1.1	20.5	35	5	80	SOT-89
SIA3024Z		0.01~3	20	21	1.1	20.5	35	5	80	Die
SIA3024		0.01~3	18.5	20.5	1.25	19.5	35	5	75	Die
SIA3024T3		0.01~3	20	18	1.3	20	35	5	75	SOT89
SIA3024SP3		0.01~3	20	20	1.3	19	35	5	67	3*3 QFN-16L

成都仕芯半导体有限公司

型号	指标	频率范围 (GHz)	增益 (dB)	饱和功率 (dBm)	噪声系数 (dB)	输出 P1dB (dBm)	输出 IP3 (dBm)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	芯片/封装尺寸
SIA199T3		0.1~4	14	22	2.1	20	34.5	5	80	SOT89
SIA283ZSP2B (New)		0.6~6	22.5	21	0.6	19.5	36	5	68	2*2 QFN-8L
SIA283SP2B		0.6~6	22.5	21.5	0.6	19.5	37	5	65	2*2 QFN-8L
SIA068		0.01~8	19	21.5	1.4	20	30	5	65	Die
SIA068SP2		0.01~8	19	22.5	1.4	20.5	34	5	65	2*2 QFN-6L
SIA070		0.01~10	15	20	2.1	18.5	32	5	65	Die
SIA070SP2		0.01~10	14.5	21	1.8	19	32	5	65	2*2 QFN-6L
SIA076		3~10	14	18	1.7	17	26	5	45	Die
SIA076SP4		3~10	13.5	18.5	1.7	17	33	5	45	4*4 QFN-24L
SIA214		2.5~11	23	18.3	1.6	16.3	31	5	71	Die
SIA214SP3B		2.5~11	22	17.5	1.7	15	28	5	67	3*3 QFN-12L
SIA269SP2		0.3~12	15.5	18	2.3	17	29	5	49	2*2 QFN-6L
SIA215		8~15	20	15.8	1.4	14.5	26.6	5	68	Die
SIA071		6~18	18.8	17	1.5	15	28	3.5	70	Die
SIA071SP3		6~18	18	17.5	1.7	15	25	3.5	75	3*3 QFN-16L
SIA095		3~21	17	17	1.5	15	28	3.5	70	Die
SIA095SP3		3~21	16	16	1.8	13.5	24	3.5	80	3*3 QFN-16L
SIA072SP5		1~24	14.2	15	2.5	13	24	5	58	5*5 QFN-32L
SIA077SP5		0.01~24	15	19	2.7	16	26	8	80	5*5 QFN-32L
SIA078SP5		0.01~24	15	19	2.7	15	29	7	55	5*5 QFN-32L
SIA198SP4		6~26.5	21	11	2.5	9	19	3.5	60	4*4 QFN-24L
SIA072		1~27	16	17	2.5	14	22	5	60	Die
SIA077		0.01~27	16	20	2.7	16	26	7	70	Die
SIA249		16~28	26	16	2.1	14	25.5	3	80	Die
SIA249SP4		16~28	25	15.5	2.1	14	25	3	83	4*4 QFN-24L
SIA134SP4		17~28	22	-	2.3	15	25	5	79	4*4 QFN-24L
SIA073SP3		24~28	19	10	3.1	7.5	17	5	61	3*3 QFN-16L
SIA075		23~40	18	15	2.5	12	22	3	65	Die
SIA075SP4		22~40	20	15.5	2.7	13	23	3	65	4*4 QFN-24L
SIA073		22~43.5	21	13	2.3	10	22	5	54	Die

成都仕芯半导体有限公司

12.2 Gain Block 放大器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	增益 (dB)	饱和功率 (dBm)	噪声 (dB)	输入驻波 (dB)	输出驻波 (dB)	输出 P1dB (dBm)	输出 IP3 (dBm)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	芯片/封装尺寸
SIA207ZSP2		DC~10	16.5	17.5	3.7	15	19	16	25.5	5	65	2*2 QFN-6L
SIA207Z		DC~12	18	17	3	15	20	16@1GHz	27@1GHz	5	65	Die
SIA205Z		DC~6	17	15	3.2	15	22	14	28	5	50	Die
SIA204Z		DC~3	22	13.5	2.4	20	18	12	24.5	5	33	Die
SIA204		DC~3	22	13.5	3.5	23	17	12	24.5	5	33	Die
SIA204SP2		DC~3	22	13.5	3.5	23	17	12	24.5	5	33	2*2 DFN-6L
SIA241		DC~3	20	15	2.5	19	22	14@1GHz	26@1GHz	5	35	Die
SIA241SP2		DC~3	19	15	2.5	17	20	14@1GHz	26@1GHz	5	35	2*2 DFN-6L
SIA241T3		DC~3	20	15	2.2	17	21	14@1GHz	26@1GHz	5	35	SOT89
SIA243		DC~4	21	19	2.9	19	21	18@1GHz	30@1GHz	5	64	Die
SIA205		DC~6	17	15	3.6	17	20	14	28	5	50	Die
SIA205SP2		DC~6	17	15	3.6	17	20	14	28	5	50	2*2 DFN-6L
SIA240		DC~6	16	15	3	20	26	14@1GHz	28@1GHz	5	40	Die
SIA240SP2		DC~6	16	15	2.9	15	20	14@1GHz	28@1GHz	5	40	2*2 DFN-6L
SIA240T3		DC~6	16	15	2.9	22	25	14@1GHz	28@1GHz	5	40	SOT89
SIA244		0.05~6	17	16	3.8	15	18	15.3@1GHz	28@1GHz	5	42	Die
SIA244T3		0.05~6	17	16	3.5	15	18	15.3@1GHz	28@1GHz	5	42	SOT89
SIA239		DC~8	12	13	4	16	17	12.5@1GHz	28@1GHz	5	40	Die
SIA239SP2		DC~8	12	13.5	4	16	17	12.5@1GHz	28@1GHz	5	40	2*2 DFN-6L
SIA207T3		DC~10	20	19	3.5	18	22	18@1GHz	29@1GHz	5	65	SOT89
SIA207		DC~12	20	18.5	3.5	18	22	18@1GHz	29@1GHz	5	65	Die
SIA207SP2		DC~12	20	18.5	3.5	18	22	18@1GHz	29@1GHz	5	65	2*2 DFN-6L

12.3 中功率放大器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	增益 (dB)	饱和功率 (dBm)	噪声 (dB)	输出 P1dB (dBm)	输出 IP3 (dBm)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	芯片/封装尺寸
SIA130		5~18	19	21	6.5	20	30	5	115	Die
SIA130SP3		5~18	16.5	21	6.5	20	30	5	110	3*3 QFN-16L

成都仕芯半导体有限公司

12.4 低相位噪声放大器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	单边带相位噪声 (10KHz 频偏)	单边带相位噪声 (100KHz 频偏)	增益 (dB)	饱和输出功率 (dBm)	噪声 (dB)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	芯片/封装尺寸
<u>SIA247ZSP3 (New)</u>		0.01~3	/	-167	20	20.5	1.1	5	80	3*3 QFN-16L
SIA247ZT3		0.01~3	/	-167	20	20.5	1.1	5	80	SOT89
SIA247Z		0.01~3	/	-167	20	20.5	1.1	5	80	Die
SIA354ZSP5		2~20	-154	-159	14	14	5.5	5	80	5*5 QFN-32L
SIA354Z		2~20	-154	-159	14	14	4.5	5	75	Die
SIA206		0.01~1	-175	-176	20.5	22	3.7	5	86	Die
SIA206SP2		0.01~1	-175	-176	20.5	22	3.7	5	86	2*2 QFN-6L
SIA206T3		0.01~1	-175	-176	20.5	22	3.3	5	86	SOT89
SIA352		0.01~2.5	-164	-171	19	14	3	5	25	Die
SIA352SP2		0.01~2.5	-164	-171	19	14	3	5	25	2*2 QFN-6L
SIA247		0.01~3	-168	-173	18.5	20.5	1.25	5	75	Die
SIA247T3		0.01~3	-168	-173	18.5	20.5	1.3	5	75	SOT89
SIA247SP3		0.01~3	-168	-173	18	20	1.3	5	67	3*3 QFN-16L
SIA242		DC~4	-171	-173	19	19	3	5	65	Die
SIA242SP2		DC~4	-171	-173	18	19	3	5	65	2*2 DFN-6L
SIA242T3		DC~4	-171	-173	19	19	2.7	5	65	SOT89

12.5 运算放大器芯片

型号	指标	VCC 电源输入范围 (V)	开环直流高增益 (dB)	输入失调电压 (μ V)	输入失调电流 (nA)	单位增益带宽积 (MHz)	输入偏置电流 (nA)	压摆率 (V/ μ s)	芯片/封装尺寸
<u>S10A201ZSP3 (New)</u>		2.7~5.5	135	110	70	60	75	4.5	3*3 QFN-16L
<u>S10A201Z (New)</u>		2.7~5.5	135	110	70	60	75	4.5	Die

成都仕芯半导体有限公司

13 倍频器芯片

13.1 二倍频器芯片

型号	指标	输入频率范围 (GHz)	输出频率范围 (GHz)	输出功率 (dBm)	输入回波损耗 (dB)	输出回波损耗 (dB)	F0 泄露 (dBc)	芯片/封装尺寸
SIMU125SP3B		8~12	15~24	17	11	13	27	3*3 QFN-12L
SIMU125		8~13	15~26	16	15	8	20	Die
SIMU126		10.5~15.5	21~31	18	9	11	20	Die
SIMU126SP3B		10~15.5	20~31	17	10	10	20	3*3 QFN-12L

14 数模转换器芯片

14.1 10 位数模转换器芯片

型号	指标	功能	输出范围 (V)	分辨率 (bit)	INL (LSB)	DNL (LSB)	满摆幅建立时间 (us)	工作电压 (V)	功耗 (mW)	芯片/封装尺寸
SIDA164		高摆率电压型 DAC	0.5~16.5	10	±0.5	±0.3	0.2 (10%~90%)	4.75~5.25@VDD 17~20@VLDO	38	Die
SIDA164SP4		高摆率电压型 DAC	0.5~16.5	10	±0.5	±0.3	0.2 (10%~90%)	4.75~5.25@VDD 17~20@VLDO	38	4*4 QFN-24L

15 均衡器芯片

15.1 电调均衡器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	插损 (dB)	均衡范围 (dB)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	输入功率 (dBm)	切换时间 (ns)	芯片/封装尺寸
SIE055SP3		2~7	0.7	4~9.5	@VT=0~14	@VT=10uA	15	150	3*3 QFN-16L

16 电源芯片

16.1 LDO 电源芯片

型号	指标	输入电压范围 (V)	输出电压范围 (V)	输出电压 (V)	漏失电压 (V)	输出电压误差 (%)	输出电流 (mA)	到地电流 (mA)	芯片/封装尺寸
SIL417ZSP3 (New)		4~5.8	1.1~5.2	5	0.6	3	250	1.1	3*3 QFN-16L

成都仕芯半导体有限公司

17 开关芯片

指标 型号	类型	频率范围 (GHz)	插损 (dB)	隔离度 (dB)	回波损耗 (dB)	偏置电压 (V)	控制电压 (V)	响应时间 (ns)	芯片/封装尺寸
SIS403Z	单刀双掷	0.1~40	1.9	38	15	5	0~5	20	Die
SIS402Z	单刀单掷	0.1~20	1.0	50	20	5	0~5	45	Die
SIS399Z	单刀单掷	0.1~40	1.2	40	15	5	0~5	45	Die
SIS342ZSP3	单刀双掷	0.01~20	1.3	51	20	-5	0~5	27	3*3 QFN-16L
SIS342Z/SIS342ZM	单刀双掷	0.01~20	1.3	52	23	-5	0~5	27	Die
SIS376SL3	单刀双掷	9kHz~44	1.0	63	15	+3.3/-3.3	0~3.6	800	3*3 LGA-20L
SIS119SL3	单刀双掷	100MHz~44	1.2	60	17	+3.3/-3.3	0~3.6	17	3*3 LGA-20L
SIS313SL3	单刀四掷	9kHz~44	1.6	59	15	+3.3/-3.3	0~3.6	400	3*3 LGA-20L
SIS375SL3	单刀四掷	100MHz~44	1.4	62	15	+3.3/-3.3	0~3.6	12	3*3 LGA-20L
SIS110BSP3	单刀双掷	9kHz~13	0.7	45	21	3~5	0~3.6	880	3*3 QFN-16L
SIS343Z	单刀单掷	9kHz~20	1.0	57	23	-5	0~5	24	Die
SIS383Z	单刀单掷	9kHz~20	1.0	58	23	-5	0~5	209	Die
SIS216ZSP3	单刀双掷	0.01~20	1.3	60	15	3~5	0~5	15	3*3 QFN-16L
SIS216Z	单刀双掷	0.02~20	1.3	60	20	3~5	0~5	8	Die
SIS344ZSP3	单刀四掷	0.1~20	2.0	44	13	5	0~5	25	3*3 QFN-16L
SIS344Z/SIS344ZM	单刀四掷	9kHz~20	1.7	50	17	-5	0~5	17	Die
SIS384Z	单刀四掷	9kHz~20	1.6	50	17	-5	0~5	237	Die
SIS388ZSP3	单刀四掷	0.1~20	2.0	44	13	5	0~5	25	3*3 QFN-16L
SIS388Z	单刀四掷	0.1~20	1.7	51	20	5	0~5	27	Die
SIS292SP5	单刀五掷	0.03~2	0.4	48dB@TX-TX 50dB@TX-RX	15	5V@VDD -3.3V@VSS	0~5	4000	3*3 QFN-16L
SIS084SP3	单刀双掷	0.1~6	0.65~1	60dB@0.1GHz~2GHz 50dB@2GHz~4GHz 45dB@4GHz~6GHz	20	3	0~3.3	60	3*3 QFN-16L
SIS085	单刀四掷	0.1~6	0.8~1.9	50dB@0.1GHz~2GHz 40dB@2GHz~4GHz 33dB@4GHz~6GHz	20	3	0~3.3	140	Die

成都仕芯半导体有限公司

指标 型号	类型	频率范围 (GHz)	插损 (dB)	隔离度 (dB)	回波损耗 (dB)	偏置电压 (V)	控制电压 (V)	响应时间 (ns)	芯片/封装尺寸
SIS085SP3	单刀四掷	0.1~6	0.8~1.2	65dB@0.1GHz~2GHz 55dB@2GHz~4GHz 42dB@4GHz~6GHz	20	3	0~3.3	300	3*3 QFN-16L
SIS378SP3	单刀双掷	0.1~13	0.7	49dB	22	3~5	0~3.6	31	3*3 QFN-16L
SIS108SP4B	单刀双掷	0.01~7	0.8~1.4	60dB@0.01GHz~2GHz 50dB@2GHz~4GHz 45dB@4GHz~7GHz	15	3.3~5	0~5	50	4*4 QFN-16L
SIS128SP4	单刀五掷	0.01~8	1.3~2.3	71dB@10MHz~900MHz 59dB@900MHz~2.6GHz 53dB@2.6GHz~8GHz	12	3~5	0~5	45	4*4 QFN-24L
SIS110ASP3	单刀双掷	0.01~13	0.8	50dB@10MHz~6GHz 38dB@6GHz~8GHz 30dB@8GHz~13GHz	15	3~5	0~5	30	3*3 QFN-16L
SIS252	单刀双掷	0.01~20	2.3	50	15	3~5	0~5	16	Die
SIS252SP3	单刀双掷	0.01~20	2.3	50	15	3~5	0~5	16	3*3 QFN-16L
SIS037	单刀四掷	0.01~20	2~3.2	50dB@10MHz~10GHz 55dB@10GHz~20GHz	17	-5	0~5	18	Die
SIS037SP4	单刀四掷	0.01~20	2~3.2	50dB@10MHz~10GHz 55dB@10GHz~20GHz	17	-5	0~5	18	4*4 QFN-24L
SIS041	单刀单掷	0.01~30	1.3~1.8	60dB@10MHz~15GHz 50dB@15GHz~20GHz 40dB@20GHz~30GHz	15	-5	0~5	20	Die

注：SISXXX 与 SISXXXM 互为镜像版本。

18 移相器芯片

18.1 模拟移相器芯片

型号	指标	功能	频率范围 (GHz)	移相范围 (deg)	插入损耗 (dB)	回波损耗 (dB)	VT 电压 (V)	VT 电流 (uA)	灵敏度 (deg/V)	移相切换时间 (us)	芯片/封装尺寸
SIP050SP5		360deg 连续移相	0.95~2	>360	5	18	0~14	10	28	0.24	5*5 QFN-32L
SIP051SP5		360deg 连续移相	1.8~3.8	>360	4	20	0~14	10	27	0.24	5*5 QFN-32L
SIP064SP5		360deg 连续移相	2.3~5	>360	4.5	18	0.3~14	10	29	0.24	5*5 QFN-32L
SIP052SP5		360deg 连续移相	3~6	>360	3.5	15	0~14	10	26	0.25	5*5 QFN-32L
SIP012SP4		180deg 连续移相	2~7	>180	2	15	0~14	10	15	0.24	4*4 QFN-24L
SIP371ASP5 (New)		360deg 连续移相	3.3~9	>360	4	15	1~6	10	75	0.24	5*5 QFN-32L
SIP371SP5		360deg 连续移相	3.3~8.5	>360	4.5	15	1~15	10	29	0.24	5*5 QFN-32L
SIP013SP4		180deg 连续移相	3~13	>180	2.5	14	0~13	10	18	0.14	4*4 QFN-24L
SIP053SP4		180deg 连续移相	6~18	>180	3	15	0.5~15	10	15	0.14	4*4 QFN-24L
SIP015SP4		360deg 连续移相	7~12.5	>360	4	14	0~14	1	28	0.15	4*4 QFN-24L
SIP016SP4		360deg 连续移相	11~18	>360	5	14	0~14	1	26.5	0.12	4*4 QFN-24L
SIP017SP4		360deg 连续移相	18~26.5	>360	4.5	15	0~16	10	24	0.12	4*4 QFN-24L
SIP054SP3		360deg 连续移相	24.5~31	>360	5	13	0~14	10	35	0.12	3*3 QFN-16L

18.2 数字移相器芯片

型号	指标	功能	频率范围 (GHz)	插入损耗 (dB)	回波损耗 (dB)	移相寄生调幅 (dB)	RMS 衰减误差 (dB)	RMS 移相误差 (deg)	移相切换时间 (ns)	芯片/封装尺寸
SIP279SP4		最大移相 360° , 步进: 5.6°	2.3~3.8	3.5	1.3:1	±0.3	0.3	3	50	4*4 QFN-24L
SIP281SP4		最大移相 360° , 步进: 5.6°	3.5~6	5.5	1.8:1	±0.8	0.4	4	50	4*4 QFN-24L

18.3 模拟延迟线芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	可调延时 (ps)	插入损耗 (dB)	回波损耗 (输入 & 输出) (dB)	VT 电压 (V)	VT 电流 (uA)	延时灵敏度 (ps/V)	切换时间 (ns)	芯片/封装尺寸
SIP066		DC~20	0~25	3	20	0~15	10	2	120	Die
SIP066SP4		DC~20	0~25	3	20	0~15	10	2	120	4*4 QFN-24L

19 滤波器芯片

19.1 固定低通滤波器芯片

型号	指标 频率范围 (GHz)	插入损耗 (dB)	输入回波损耗 (dB)	输出回波损耗 (dB)	带外抑制 (dBc)	芯片/封装尺寸
SIF0010Z	DC~1	1.7	17	18	20@1.6GHz 51@2.3GHz	Die
SIF0012Z	DC~12	1.4	23	20	25@16.6GHz 52@18.8GHz	Die
SIF0013Z	DC~13	1.3	20	22	25@17.8GHz 40@19.8GHz	Die
SIF0014Z	DC~14	1.3	27	23	28@19.4GHz 44@22.1GHz	Die
SIF0015Z	DC~15	1.4	19	22	35@20.1GHz	Die
SIF0016Z	DC~16	2.4	18	17	31@19.5GHz 47@21.1GHz	Die
SIF0020Z	DC~2	1.1	21	20	25@3.1GHz 53@3.6GHz	Die
SIF0025Z	DC~2.5	1.5	22	18	30@4.0GHz 51@4.7GHz	Die
SIF0030Z	DC~3	1.8	23	23	24@4.3GHz 56@5.2GHz	Die
SIF0035Z	DC~3.5	1.5	19	18	19@5.0GHz 40@5.9GHz	Die
SIF0040Z	DC~4	2.0	21	18	24@5.2GHz 41@5.8GHz	Die
SIF0045Z	DC~4.5	1.8	21	18	43@6.9GHz 52@7.7GHz	Die
SIF0050Z	DC~5	1.7	20	24	27@7.2GHz 38@7.9GHz	Die
SIF0055Z	DC~5.5	1.7	25	21	27@8.1GHz 42@9.1GHz	Die

成都仕芯半导体有限公司

19.2 固定高通滤波器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	插入损耗 (dB)	输入回波损耗 (dB)	输出回波损耗 (dB)	带外抑制 (dBc)	芯片/封装尺寸
SIF0220Z		2~20	1.6	15	14	51@1.0GHz 40@1.2GHz	Die

19.3 固定带通滤波器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	插入损耗 (dB)	输入回波损耗 (dB)	输出回波损耗 (dB)	带外抑制 (dBc)	芯片/封装尺寸
SIF0306Z		2.7~6.2	2.7	16	17	62@1.5GHz 60@9.0GHz	Die
SIF0812Z		7.7~12.6	2.6	15	14	62@4.7GHz 39@16GHz	Die

19.4 电调低通滤波器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	插入损耗 (dB)	工作电压 (V)	工作电流 (uA)	P1dB 输入功率 (dBm)	切换时间 (ns)	芯片/封装尺寸
SIF261SP8		0.5~2	3.5	@VT=0~15	@0.12	25	250	8*8 QFN-56L
SIF063SP4		2~4	2~2.8	@VT=0~15	@VT=10	15	200	4*4 QFN-24L
SIF262SP7		2~8	2.5	@VT=0~15	0.21	25	250	7*7 QFN-48L

19.5 电调带通滤波器芯片

型号	指标	频率范围 (GHz)	插入损耗 (dB)	均衡量 (dB)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	P1dB 输入功率 (dBm)	切换时间 (ns)	相对带宽 (%)	芯片/封装尺寸
SIF056		2~4	5~7.5	3	@VT=0~15	@VT=10uA	15	350	63	Die
SIF056SP5		2~4	5~7.5	3	@VT=0~15	@VT=10uA	15	350	63	5*5 QFN-32L
SIF057		2~4	3.5~7	3	@VCC=5	30	15	250	13	Die
SIF057SP5		2~4	3.5~7	3	@VCC=5	30	15	250	13	5*5 QFN-32L
SIF058		4~8	3.7~5	1.3	@VT=0~15	@VT=10uA	15	200	43	Die
SIF058SP4		4~8	3.7~5	1.3	@VT=0~15	@VT=10uA	15	200	43	4*4 QFN-24L
SIF060SP5		4~8	5~8	-	@VCC=5	30	15	250	9	5*5 QFN-32L
SIF059SP4		5~10	4~6	2	@VT=0~15	@VT=10uA	15	160	43	4*4 QFN-24L
SIF061		8~16	6.6~9.1	2.5	@VT=0~15	@VT=10uA	15	120	24	Die
SIF061SP3		8~16	6.6~9.1	2.5	@VT=0~15	@VT=10uA	15	120	24	3*3 QFN-16L
SIF062		10.5~20	7~9	2	@VT=0~15	@VT=10uA	15	100	24	Die
SIF062SP3		10.5~20	7~9	2	@VT=0~15	@VT=10uA	15	100	24	3*3 QFN-16L

附录 封装外形简介

1 塑料封装

仕芯内部封装代码	封装类型	封装尺寸 (mm)	引脚数量	接地焊盘 (mm)	引脚间距 (mm)	引脚宽度 (mm)	引脚长度 (mm)	框架镀层	封装厚度 (mm)
SP2	DFN	2×2	6L	1.00×1.60	0.65	0.30	0.25	NiPdAu. Std	0.75
SP3	QFN	3×3	16L	1.56×1.56	0.50	0.25	0.40	NiPdAuAg	0.75
SP3B	QFN	3×3	12L	1.15×1.15	0.50	0.22	0.50	NiPdAuAg	0.75
SP4	QFN	4×4	24L	2.56×2.56	0.50	0.25	0.40	NiPdAuAg	0.75
SP4-2	QFN	4×4	24L	2.70×2.70	0.50	0.25	0.40	NiPdAuAg	0.75
SP4B	QFN	4×4	16L	2.70×2.70	0.65	0.30	0.40	NiPdAu. Std	0.75
SP5	QFN	5×5	32L	3.45×3.45	0.50	0.25	0.40	NiPdAuAg	0.75
P8	eSOP	3.9×4.9	8L	2.29×3.81	1.27	0.41	0.64	RT-PPF	1.55
SP4B-2	QFN	4×4	16L	2.40×2.40	0.65	0.30	0.55	NiPdAuAg	0.75
T3	SOT89	4.5×2.5	3L	1.75×2.84	1.50	0.53	1.00	Ag. Spot	1.49
SP2B	DFN	2×2	8L	0.90×1.60	0.50	0.25	0.30	NiPdAu. Std	0.75
SP2C	QFN	2×2	10L	0.50×0.50	0.50	0.25	0.30	NiPdAuAg	0.75
SP5B	QFN	5×5	24L	3.20×3.20	0.65	0.30	0.55	NiPdAuAg	0.75
SP3-5	QFN	3×3	16L	1.70×1.70	0.50	0.25	0.30	NiPdAuAg	0.75
P10	eMSOP	3×3	10L	2.05×1.88	0.50	0.22	0.95	Ag. Spot	0.95
SP6	QFN	6×6	40L	4.50×4.50	0.50	0.25	0.40	NiPdAuAg	0.75
SP4C	QFN	4×4	32L	2.70×2.70	0.40	0.20	0.35	Ag. Spot	0.75
SL3	LGA	3×3	20L	1.5×1.5	0.40	0.20	0.275	NiPdAu	0.665
SP23	FCQFN	3×2	12L	0.77×0.25	0.50	0.25	0.4	Ag Spot	0.75

2 陶瓷封装

仕芯内部封装代码	封装类型	封装尺寸 (mm)	引脚数量	接地焊盘 (mm)	引脚间距 (mm)	引脚宽度 (mm)	引脚长度 (mm)	管壳镀层	封装厚度 (mm)
SC3	CQFN	3×3	16	1.50×1.50	0.50	0.30	0.45	NiAu	0.80
SC4	CQFN	4×4	24	2.50×2.50	0.50	0.30	0.45	NiAu	1.00
SC5	CQFN	5×5	32	3.50×3.50	0.50	0.30	0.45	NiAu	0.80
C8	CSOP	6×7.5	8	3.55×4.55	1.27	0.40	0.75	NiAu	1.60
SC4B	CQFN	4.6×4.6	16	2.60×2.60	0.50	0.30	0.70	NiAu	1.20

封装包含塑封和陶封，两种封装种类齐全。

塑封 DFN (四边扁平无引线塑料封装) 和 QFN (四边扁平无引线塑料封装) 具有良好的电和热性能、体积小、重量轻，非常适用于射频芯片的封装；SOP (Small Out-Line Package 小外形封装) / SOT (小外形晶体管封装)，具有集成度高性能优良，可靠性高，体积小、重量轻、封装密度大。

陶封 CQFN 和 CSOP 具有优良的电、热、机械性能。能提供 IC 芯片气密性的密封保护，能满足更高可靠性能要求。



成都仕芯半导体有限公司

Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd.

用户至上、以人为本

严谨高效、技术创新

我们专注于提供：

射频微波、毫米波及数模混合集成电路芯片

- 完全自主知识产权的高集成度、高频率集成电路芯片
- 行业内领先的性能指标
- 标准化接口，易于使用
- 多种封装形式（QFN塑封、陶封、DIE）可供选择

集成电路芯片评估板

- 覆盖集成电路芯片产品的所有型号
- 对产品性能还原准确，便于充分验证
- 同类产品可通用，可重复利用

业内顶尖的技术服务支持

- 具有丰富自主知识产权的创新性设计
- 专业的产品技术及应用支持
- 为客户提供具有国际竞争力的独家定制设计服务

中国 成都

座 机：028-62680968

手 机：156 8059 5809

传 真：028-62680967

技术支持：info@sicoresemi.com

网 址：www.sicoresemi.com

地 址：成都市高新西区百川路9号

仕芯公众号

